
2SD1609 , 2SD1610

シリコン NPN エピタキシャル形

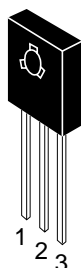
HITACHI

特長

- 低周波電力増幅用
- 2SB1109 , 2SB1110 とコンプリメンタリペア

外観図

TO-126 MOD



1. Emitter
2. Collector
3. Base

絶対最大定格

(Ta = 25)

項目	記号	2SD1609	2SD1610	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	160	200	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	160	200	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	5	V
コレクタ電流	I_C	100	100	mA
許容コレクタ損失	P_C	1.25	1.25	W
接合部温度	T_j	150	150	
保存温度	T_{stg}	-45 ~ +150	-45 ~ +150	

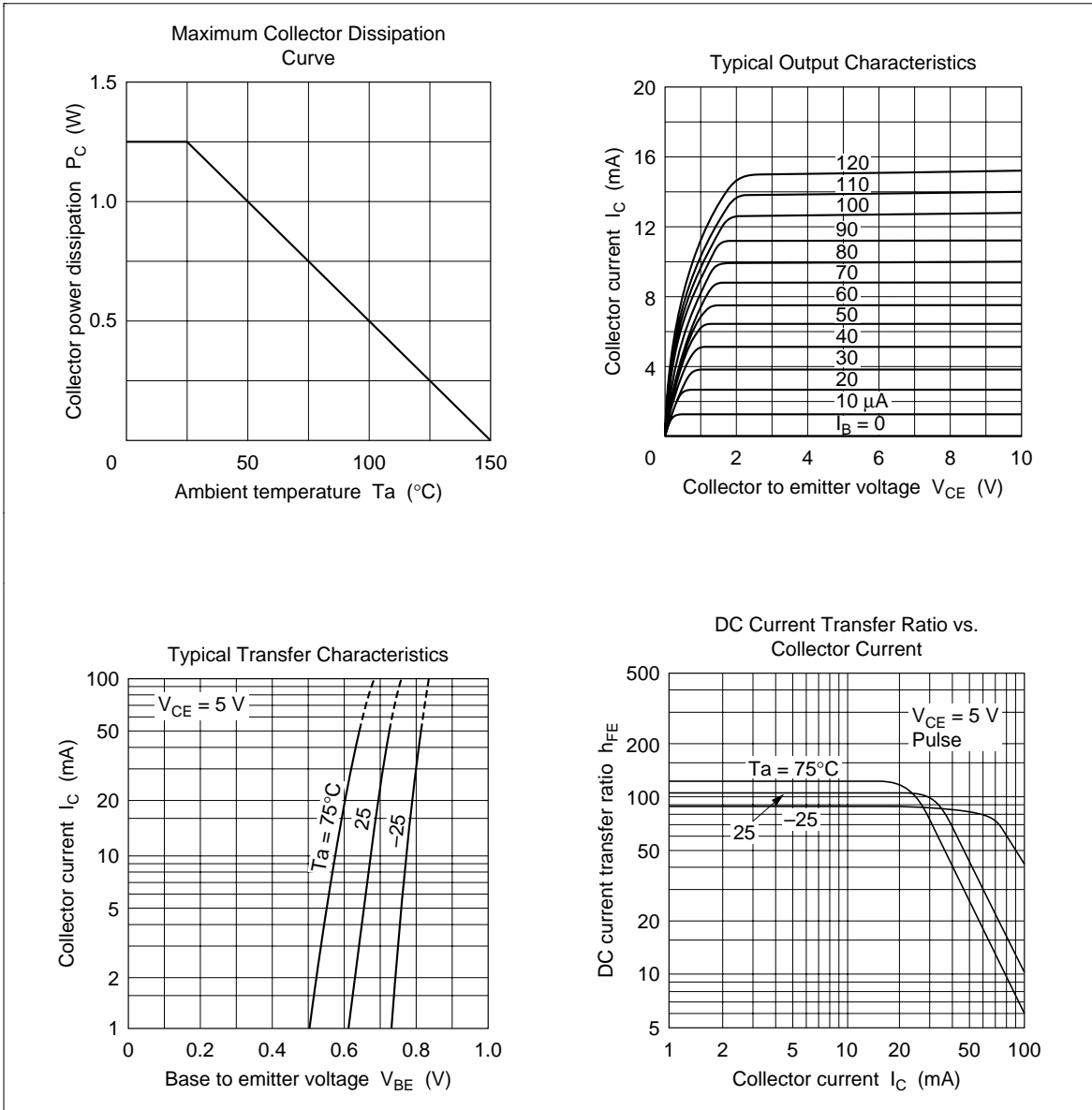
電気的特性

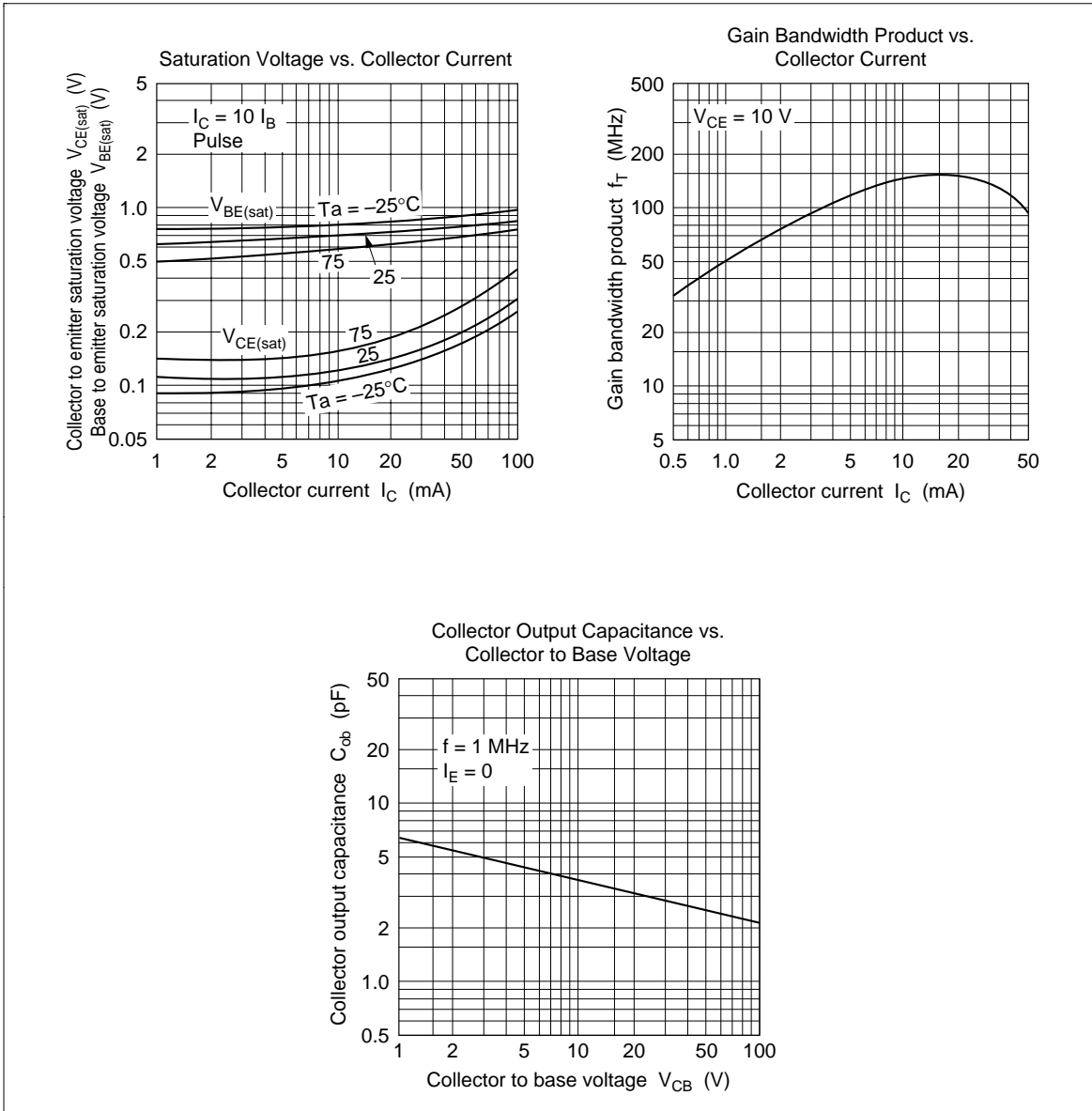
(Ta = 25)

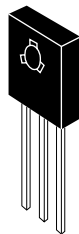
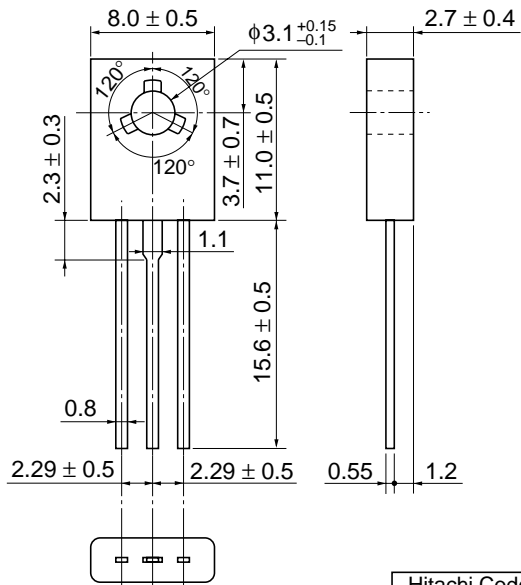
項目	記号	2SD1609			2SD1610			単位	測定条件
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	160	—	—	200	—	—	V	$I_C = 10\mu A, I_E = 0$
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	160	—	—	200	—	—	V	$I_C = 1mA, R_{BE} =$
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	5	—	—	5	—	—	V	$I_E = 10\mu A, I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	10	—	—	—	μA	$V_{CB} = 140V, I_E = 0$
		—	—	—	—	—	10		$V_{CB} = 160V, I_E = 0$
直流電流増幅率	h_{FE1}^{*1}	60	—	320	60	—	320		$V_{CE} = 5V, I_C = 10mA$
	h_{FE2}	30	—	—	30	—	—		$V_{CE} = 5V, I_C = 1mA$
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	—	—	1.5	—	—	1.5	V	$V_{CE} = 5V, I_C = 10mA$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	2	—	—	2	V	$I_C = 30mA, I_B = 3mA$
利得帯域幅積	f_T	—	140	—	—	140	—	MHz	$V_{CE} = 5V, I_C = 10mA$
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	3.8	—	—	3.8	—	pF	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$

【注】 1. 2SD1609, 2SD1610 は h_{FE1} の値により下記のように3区分し, 現品に表示してあります。

B	C	D
60 ~ 120	100 ~ 200	160 ~ 320







Hitachi Code	TO-126 Mod
JEDEC	—
EIAJ	—
Weight (reference value)	0.67 g